

## ZD8.2

### 硅外延平面稳压二极管芯片 (4")

■用途:

\*用于稳压电路

■特征:

\*稳压范围 8.2V(±5%)

\*耗散功率 0.5W

\*适用于 SOT-23 封装

\*有效图形数: 56150 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	350μm×350μm
压焊区尺寸	180μm×180μm
芯片厚度	180±10μm
锯片槽宽度	50μm
金属层	正面: Al 2.3±0.2μm 背面: Au 1.4±0.2μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	典型值	单位
稳压值	$V_Z$	$I_Z=5.0\text{mA}$	7.7	8.7	8.2	V
输出阻抗	$Z_{ZT}$	$I_{ZT}=5.0\text{mA}$		15		$\Omega$
	$Z_{ZK}$	$I_{ZK}=1.0\text{mA}$		80		$\Omega$
反向漏电流	$I_R$	$V_R=5.0\text{V}$		0.7		$\mu\text{A}$
正向电压	$V_F$	$I_F=10\text{mA}$		0.9		V